ハイパスフィルタ・900–6000 MHz

阻止域減衰量 ≥40 dB (DC–650 MHz). 筐体寸法 10 ± 0.2 × 7.5 ± 0.2 × 4 ± 0.3 mm.

RF 特性

項目	値
通過帯域	900–6000 MHz
通過帯域内挿入損失 [1]	≤2 dB
阻止域減衰量 [2]	≥40 dB
VSWR [1]	≤1.8:1

[1] 900–6000 MHz
[2] DC–650 MHz

設計定格 設計値

項目	値
動作温度	–40...+70 °C
保存温度	–55...+85 °C
許容電力	1 W

代表実測応答

周波数 (MHz)	S11 VSWR	S22 VSWR	S12 損失（dB）	S12 抑圧（dB）	S12 遅延（ns）
10	92692.81	1760.72	-81.55	-81.55	5.29
140	2756.14	4876.68	-48.09	-48.09	3.21
290	362.47	581.95	-47.62	-47.62	0.33
430	116.94	157.04	-64.44	-64.44	-1.28
570	48.47	63.92	-52.41	-52.41	-1.78
710	20.76	25	-48.87	-48.87	-0.29
860	1.32	1.36	-1.64	-1.64	0.8
1000	1.07	1.06	-0.82	-0.82	1.85
1140	1.24	1.26	-0.65	-0.65	1.05
1290	1.25	1.26	-0.57	-0.57	0.71
1430	1.22	1.22	-0.51	-0.51	0.56
1570	1.18	1.17	-0.47	-0.47	0.48
1710	1.15	1.15	-0.45	-0.45	0.42

代表実測応答

周波数 (MHz)	S11 VSWR	S22 VSWR	S12 損失（dB）	S12 抑圧（dB）	S12 遅延（ns）
1860	1.11	1.13	-0.43	-0.43	0.37
2000	1.08	1.13	-0.41	-0.41	0.35

機械仕様

項目	値
筐体寸法	10 ±0.2 × 7.5 ±0.2 × 4 ±0.3 mm
RF 端子	表面実装
品質グレード	産業用
パッケージRF端子の内縁間隔	8.8 mm
基板RFランドの内縁間隔	8.6 mm
対向するクリアランスの内縁間隔	7.2 mm
短辺方向のクリアランス開口幅	2.6 mm
パッケージRF端子幅	1.0 mm
基板RFランドの短辺方向幅	1.2 mm
パッケージRF端子の切り欠き径	Ø0.6 mm

実装とプリント基板レイアウト

底面視では、入出力を入れ替えられる2つのRF端子が対向する短辺の中央にあります。底面の斜線部はGNDです。基板中央寄りの各RFランドに50 Ω給電線を配線し、グラウンド銅箔との間隔を確保してください。フットプリントの周囲と下にグラウンドビアを設けてください。 推奨基板レイアウトの比誘電率は3.48、誘電体厚は0.254 mmです。 独立したキャビティへの実装を推奨します。十分な接地を確保するため、可能な限りパッケージの側面、上面および底面をアセンブリの金属筐体に密着させてください。接地が不十分だと阻止域の抑圧が低下します。220 °Cでのリフローはんだ付けに対応します。清掃時はフィルタを洗浄液に浸さず、表面のみを清掃してください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。